## ZnPc/C<sub>60</sub>バルクヘテロ接合の光 CELIV 測定

## 兵県大院物質理学研究科

## o森雄一、 佐藤井一、 田島裕之

# Photo CELIV measurements of ZnPc/C<sub>60</sub> bulk-heterojunction Graduate School of Material Science. University of Hyogo. oY.Mori, S.Sato, H.Tajima

### 【序論】

ドナー(D)とアクセプター(A)からなるバルクヘテロ接合型有機薄膜太陽電池で は、光照射後にDあるいはA分子内でFrenkel励起子が最初に生成する。ついで Frenkel励起子はドナー・アクセプター界面へと拡散していき、geminate対(D+A、 電荷移動励起子とも呼ばれる)を生成する。geminate対はFrenkel励起子と比べる とクーロン束縛エネルギーが小さいため、熱あるいは外部電場により分離し電荷キャ リアを生成する。したがって、より多くの電荷キャリアを生成するためにはgeminate 対密度を高めると同時に、geminate対の結合エネルギーを小さくすることが必要で ある。このような観点から、geminate対密度の結合エネルギー依存性(以下 geminate 対密度関数)は有機薄膜太陽電池の特性を大きく左右する。以前我々は P3HT/PCBM を活性層に用いた太陽電池光において、光 CELIV(Charge Extraction by Linearly Increasing Voltage)法によってこの密度関数を求める方法を提案した[1]。本研究で は、ZnPc/C60を用いた有機薄膜太陽電池について、極低温下で光 CELIV 測定を行 うことによって geminate 対密度関数を求めることを試みた。

### 【実験】

図1に本実験で用いた試料の構造図を示す。活性層にはお よそ70nmの厚さをもつ亜鉛フタロシアニンとフラーレンの 共蒸着膜を用いた。

光 CELIV 測定ではパルス光をまず試料に照射し活性層内 でキャリアを生成する。数µs~数 msの遅延時間(td)後に三角 パルス電圧を印加することでこれらを試料の外へ放出し、こ のときに流れる電流値の波形もしくは積分値を計測する。図 2 に実際の CELIV 測定で観測された波形を示す。図 2 中で、 上は印加電圧の波形、下は光照射なし(黒線)と光照射あり(赤



#### 図 1. 試料の構造図

線)の場合の電流値の波形をそれぞれ示している。図2下図中の斜線で示した箇所が 光照射ありとなしの場合の差である。図の斜線箇所が CELIV シグナルに対応する。 【結果・考察】

光強度依存性の実験を行い、CELIV シグナルの形 状が光強度によらないことを確認した。このことか ら、本測定で得られる CELIV シグナルは、電気的に 中性の励起子(特に geminate 対)に由来している ことがわかる。図3に、2K~90Kでの測定結果から光 照射なしの場合の波形を引いたものをプロットした 図を示す。さらにこれらの波形のうち、2Kの温度下 での測定結果(黒線)について解析を行った結果を図4 に示す。この図はそれぞれ縦軸に geminate pair の密 度、横軸にその解離(結合)エネルギーをとっている。 また図4中の左図はP3HT/PCBMを用いた先行実験 で得られたグラフ、右図は今回のZnPc/C60を用い た実験で得られたグラフである。赤線で示したもの は測定データを解析したものであり、青線で示した ものは赤線に対してガウス関数を用いてフィッテ ィングしたものである。左右の図を見比べると、ど ちらについても geminate pair の解離エネルギーの 分布はガウス分布になっていることが分かる。この ことから、光照射で生成した geminate pair の密度 関数はガウス分布になると考えられる。

[1] Tajima H et al, Organic Electronics 13(2012), pp.2272-2280



図 2. 光 CELIV 測定で検出された波 形。印加電圧の波形(上図)と試料に流 れた電流の波形(下図)。



図3. 図2下図中の斜線部のみを プロットしたもの



図 4. Geminate pair の密度関数分布。P3HT/PCBM を用いた試料での結果(左図)と ZnPc/C60を用いた試料での結果(右図)。